

01; 02

© 1990 г.

## ОБРАЗОВАНИЕ АВТОИОНИЗАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ БЫСТРЫХ ИОНОВ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕЗАРЯДКИ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ

*Ш. Д. Куникеев, В. С. Сенашенко*

Дается теоретическое описание образования автоионизационных состояний в процессах перезарядки с возбуждением быстрых ионов на атомах. Обсуждаются вычисленные в различных приближениях полные сечения возбуждения низших АИС быстрых атомов гелия, образующихся в результате столкновений  ${}^3\text{He}^+ + \text{He} \rightarrow {}^3\text{He}^{**} + \text{He}^+$  в области энергий сталкивающихся частиц от 100 до 500 кэВ. Показано, что заселение автоионизационных уровней при больших энергиях столкновения происходит в основном в результате взаимодействия между собой электронов мишени и налетающего иона, а взаимодействие совершающих переходы электронов с ионом-остатком атома мишени оказывается существенным в области промежуточных энергий столкновения и приводит к заметному росту сечений образования АИС. Отмечается влияние угловой анизотропии эжекции электронов на сечение образования АИС, учет которой приводит к систематическому их уменьшению.

### Введение

Ионизационные столкновения быстрых водородоподобных ионов с атомами могут сопровождаться возбуждением и последующим распадом не только автоионизационных состояний АИС атома мишени, но и АИС рассеянного иона. Одним из возможных механизмов образования АИС быстрых ионов является перезарядка с возбуждением иона на атоме. Первоначально исследования этого явления, наблюдаемого при столкновениях многозарядных ионов с атомами, были проведены методами рентгеновской спектроскопии и ограничивались измерением полных сечений перезарядки с возбуждением [1]. Однако в дальнейшем при изучении столкновений легких ионов с атомами был использован метод оже-спектроскопии, который позволяет получать более детальную информацию, выделяя вклад от каждого АИС иона в полное сечение перезарядки с возбуждением. В последнее время этим методом были изучены энергетические спектры электронов для  $\text{He}^+ - \text{He}$  и  $\text{He}^+ - \text{H}_2$  столкновений в области энергий сталкивающихся частиц от 100 до 500 кэВ при нулевом угле эжекции электронов [2, 3].

Теоретический анализ полученных экспериментальных данных показывает, что наблюдаемые двухэлектронные переходы могут происходить под действием электрон-ядерного или электрон-электронного взаимодействия. В первом случае электрон, связанный с налетающей частицей, под действием поля экранированного заряда ядра мишени переходит в возбужденное состояние, а электрон, первоначально связанный с мишенью, под действием поля налетающей частицы захватывается в связанное возбужденное состояние рассеянного иона. При этом АИС рассеянной частицы образуется при некоррелированном движении электронов, участвующих в переходе. Во втором случае электрон, связанный с налетающей частицей, переходит в возбужденное состояние под действием поля захватываемого электрона. Этот процесс сопровождается коррелированным движением электронов и аналогичен резонансному рассеянию электронов на атомах с образованием АИС, сечение которого имеет резонансный характер [4].

Обычно при быстрых ион-атомных столкновениях простых атомных систем межэлектронные корреляции не оказывают существенного влияния и электронные переходы достаточно хорошо описываются в приближении независимых частиц [5]. Однако роль межэлектронных корреляций возрастает с уменьшением заряда ядра атома мишени. В случае двухэлектронных переходов возможны условия, когда они вносят сравнимый вклад, а порой становятся доминирующими [6]. В процессах перезарядки с возбуждением эти условия выполняются при энергии столкновения  $E_p \approx M_p (E_r + I_t)$ , где  $M_p$  — масса налетающей частицы,  $E_r$  — энергия возбуждения АИС,  $I_t$  — потенциал ионизации атома мишени.

Целью настоящей работы является теоретическое описание образования АИС быстрых ионов в процессах перезарядки с возбуждением. Основное внимание уделяется влиянию межэлектронных корреляций на характер столкновений. Обсуждаются вычисленные в различных приближениях полные сечения возбуждения низших АИС быстрых атомов гелия, образующихся в результате столкновений  ${}^3\text{He}^+ + \text{He} \rightarrow {}^3\text{He}^{**} + \text{He}^+$  в области энергий сталкивающихся частиц от 100 до 500 кэВ. Полученные результаты сравниваются с моделью Брандта—Фейгина [7, 8], развитой для быстрых столкновений сильно асимметричных систем при  $Z_p \gg Z_t$ , где  $Z_p$ ,  $Z_t$  — заряды ядер налетающей частицы и атома мишени соответственно. Главное отличие предложенного в настоящей работе теоретического описания состоит в учете влияния поля иона остатка атома мишени на движение электронов в АИС, которое становится существенным для симметричных или почти симметричных систем при  $Z_p \approx Z_t$ , и в области промежуточных энергий значительно изменяет сечения возбуждения АИС, образующихся путем перезарядки с возбуждением ионов на атомах. В работе используются атомные единицы. Часть полученных результатов была представлена в [9].

### Основные формулы

В общем случае образование и распад АИС атомных систем происходят в условиях их интерференции с непрерывным спектром, на фоне которого формируется спектр автоионизационных резонансов. Однако для рассматриваемых переходов, как показывают экспериментальные данные [2, 3], интерференция не так существенна и это позволяет обсуждать сечения образования АИС, пренебрегая их взаимодействием с непрерывным спектром. В таком случае амплитуду образования АИС можно представить в следующем виде:

$$\tau_{ex}^{LM} = \langle \chi_a^{LM} | V_{ee} + W | \Psi_i^+ \rangle, \quad (1)$$

где  $\langle \chi_a^{LM} | = \langle \Phi_a^{LM}, \vec{k}_f |$  — диагонализационная волновая функция АИС с полным орбитальным моментом  $L$  и спином  $S$ ,  $\vec{k}_f$  — импульс относительного движения рассеянного иона и атома мишени;  $V_{ee}$  и  $W$  — потенциалы взаимодействия электронов между собой и рассеянного иона в АИС с ионом-остатком атома мишени соответственно;  $\Psi_i^+$  — полная волновая функция системы в начальном состоянии.

Волновые функции  $\chi_a^{LM}$  и  $\Psi_i^+$  удовлетворяют условию  $\langle \chi_a^{LM} | \Psi_i^+ \rangle = 0$ . Если в волновой функции  $\Psi_i^+$  межэлектронными корреляциями пренебречь, то первый матричный элемент в формуле (1) описывает коррелированные переходы электронов в результате их взаимодействия между собой, а второй — некоррелированные переходы в поле экранированного заряда ядра атома мишени.

Сечение образования АИС определяется через амплитуду (1) следующим образом:

$$\sigma_{ex} = \frac{(2\pi)^4}{v_i^2} (2S + 1) \sum_M \int d\vec{Q}_\perp |\tau_{ex}^{LM}(\vec{Q}_\perp)|^2, \quad (2)$$

где  $v_i$  — скорость налетающего иона,  $\vec{Q}_\perp$  — поперечная составляющая передаваемого импульса,  $M$  — проекция орбитального момента.

В дальнейшем пренебрежем искажением континуума полем заряда  $Z_t$  при описании переходов электронов атома мишени через непрерывный спектр в состояния, связанные относительно быстрой частицы, а также влиянием экранированного поля мишени на электрон, находящийся в связанном состоянии  $\phi_0$  относительно налетающей частицы при определении  $\Psi^+$ , учитывая при этом взаимодействие активного электрона с полем заряда иона-остатка атома мишени в волновой функции связанного состояния  $\psi_0$ .

Разложим волновую функцию  $\psi_0$  в интеграл Фурье

$$\psi_0(\mathbf{r}_{2t}) = \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_{2t}} \tilde{\psi}_0(\mathbf{q}), \quad (3)$$

где  $\mathbf{r}_{it}$  — радиус-вектор  $i$ -го электрона относительно иона остатка атома мишени.

Тогда в рамках сделанных выше предположений

$$\Psi_i^+ = \varphi_0(\mathbf{r}_{1p}) \int d\mathbf{q} \tilde{\psi}_0(\mathbf{q}) \exp\left[i\left(\frac{m_t}{m_t + 1} \mathbf{k}_i + \mathbf{q}\right) \mathbf{R}_f\right] \psi_{-\mathbf{v}_i, \epsilon(\mathbf{q})}^+(\mathbf{r}_{2p}), \quad (4)$$

где  $\mathbf{r}_{ip}$  — радиус-вектор  $i$ -го электрона относительно налетающего иона,  $\mathbf{R}_f$  — расстояние между рассеянным ионом и атомом мишени,  $\psi_{\mathbf{k}, \epsilon}^+$  — двухчастичная функция рассеяния вне энергетической поверхности

$$\begin{aligned} \psi_{\mathbf{k}, \epsilon}^+ &= [1 + (\epsilon + i0 - h_{2p})^{-1} V_{2p}] |\mathbf{k}\rangle, \\ h_{2p} &= -\frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r}_{2p}}^2 + V_{2p}, \quad \epsilon(\bar{q}) = E - \epsilon_0 - \frac{1}{2\mu_f} \left( \frac{m_t}{m_t + 1} \mathbf{k}_i + \mathbf{q} \right)^2, \end{aligned} \quad (5)$$

$V_{2p}$  — потенциал взаимодействия захватываемого электрона с налетающим ионом,  $\langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = (2\pi)^{-3/2} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$  — плоская волна,  $\mathbf{k}_i$  — импульс относительного движения налетающего иона и атома мишени,  $E$  — полная энергия системы,  $\epsilon_0$  — энергия связи электрона в состоянии  $\varphi_0$ ,  $m_t$  — масса иона остатка атома мишени,  $\mu_f$  — приведенная масса рассеянного иона и иона мишени.

Если  $Z_p \sim Z_t$  и  $v_i \sim k_a$ , где  $k_a$  — «средний» импульс электрона в АИС, то влияние дальнодействующего поля иона остатка мишени на электроны становится существенным и его необходимо учитывать в волновой функции  $\chi_a^{LM}$ . Предполагая, что электроны в АИС взаимодействуют с зарядом  $Z_t$  независимо друг от друга, переопределим волновую функцию  $\chi_a^{LM}$  следующим образом

$$\chi_{a, LM}^- = \chi_a^{LM} \cdot \Phi_{\bar{v}_i}^-(v_i, \mathbf{r}_{1t}) \cdot \Phi_{\bar{v}_i}^-(v_i, \mathbf{r}_{2t}), \quad (6)$$

где искажающие множители

$$\Phi_{\bar{v}_i}^-(\mathbf{r}_{it}) = e^{-(\pi v_i t/2)} \Gamma(1 - iv_i)_1 \cdot F_1(-iv_i, 1, -i(v_i r + v_i \mathbf{r})), \quad v_i = -\frac{Z_t}{v_i} \quad (7)$$

учитывают влияние поля заряда  $Z_t$  иона остатка мишени на электрон, находящийся в АИС, рассеянной частицы.

Представим  $\Phi_{\bar{v}_i}^-$  в следующем виде:

$$\Phi_{\bar{v}_i}^-(\mathbf{r}_{it}) = \int d\mathbf{q}_i \tilde{\Phi}_{\bar{v}_i}^-(\bar{q}_i) e^{i\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{r}_{it}}, \quad i = 1, 2. \quad (8)$$

Тогда, пренебрегая остаточным взаимодействием  $W_0$  рассеянной частицы с ионом остатком мишени в операторе перехода, с учетом (4)–(6) амплитуда возбуждения (1) принимает следующий вид:

$$\tau_{ex}^{LM} = (2\pi)^3 \int d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2 \cdot \tilde{\Phi}_{\bar{v}_i}^+(\mathbf{q}_1) \cdot \tilde{\Phi}_{\bar{v}_i}^+(\mathbf{q}_2) \tilde{\psi}_0(\mathbf{q}) \langle \Phi_a^{LM} | V_{es} | \varphi_0 \psi_{\bar{q}-\bar{v}_i, \epsilon(\bar{q})}^+ \rangle, \quad (9)$$

где  $\bar{q} = -\bar{k}_t + \bar{q}_1 + \bar{q}_2$ ;  $\bar{k}_t$  — импульс, передаваемый иону-остатку мишени при столкновении.

Поскольку  $\Phi_{\bar{v}_i}^-$  имеет  $\delta$ -образную сингулярность при  $q_i = 0$ , то вынесем из-под знака интеграла в (9) матричный элемент в точке  $q_1 = q_2 = 0$ . В результате получаем

$$\tau_{\alpha\sigma}^{LM} = \langle \Phi_a^{LM} | V_{ee} | \varphi_0 \psi_{-\vec{v}_i - \vec{k}_t, E_r}^+ \rangle \langle (\Phi_{\vec{v}_i})^2 e^{-i \vec{k}_t \cdot \vec{r}} | \psi_0 \rangle. \quad (10)$$

Первый матричный элемент в формуле (10) соответствует амплитуде дипольной рекомбинации: электрон из состояния непрерывного спектра с импульсом  $-(\vec{v}_i + \vec{k}_t)$  захватывается в связанное возбужденное состояние, возбуждая при этом электрон, находящийся в связанном состоянии относительно налетающего иона. При этом в отличие от рассеяния свободных электронов рекомбинация происходит из состояния непрерывного спектра налетающего иона вне энергетической поверхности, поскольку электрон совершает переход из связанного состояния  $\psi_0$  атома мишени. Второй матричный элемент определяется с учетом искажений АИС амплитуду вероятности захватываемому электрону иметь импульс  $-\vec{k}_t$  в связанном состоянии  $\psi_0$ .

Если пренебречь искажением АИС и импульсом иона — остатка мишени  $\vec{k}_t$  в первом матричном элементе, то получаем сечение образования АИС путем коррелированных переходов в модели Брандта—Фейгина [7, 8]

$$\sigma_{ex} = \frac{(2\pi)^4}{v_i} (2S + 1) \sum_M |\langle \Phi_a^{LM} | V_{ee} | \varphi_0 \psi_{-\vec{v}_i, E_r}^+ \rangle|^2 \cdot J(p_i), \quad (11)$$

где

$$J(p_i) = \int d\mathbf{Q} |\tilde{\Phi}_0(\mathbf{Q})|^2 \delta(\mathbf{Q}\mathbf{v}_i + p_i v_i)$$

— комптоновский профиль электронов атома мишени,  $p_i = (E_r + I_t - (v_i^2/2))/v_i$ .

Из формулы (11) следует, что  $\sigma_{ex}$  как функция скорости сталкивающихся частиц  $v_i$  имеет максимум при  $v_i^2/2 = E_r + I_t$ .

### Обсуждение результатов расчетов

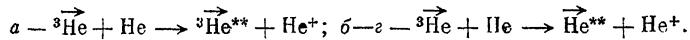
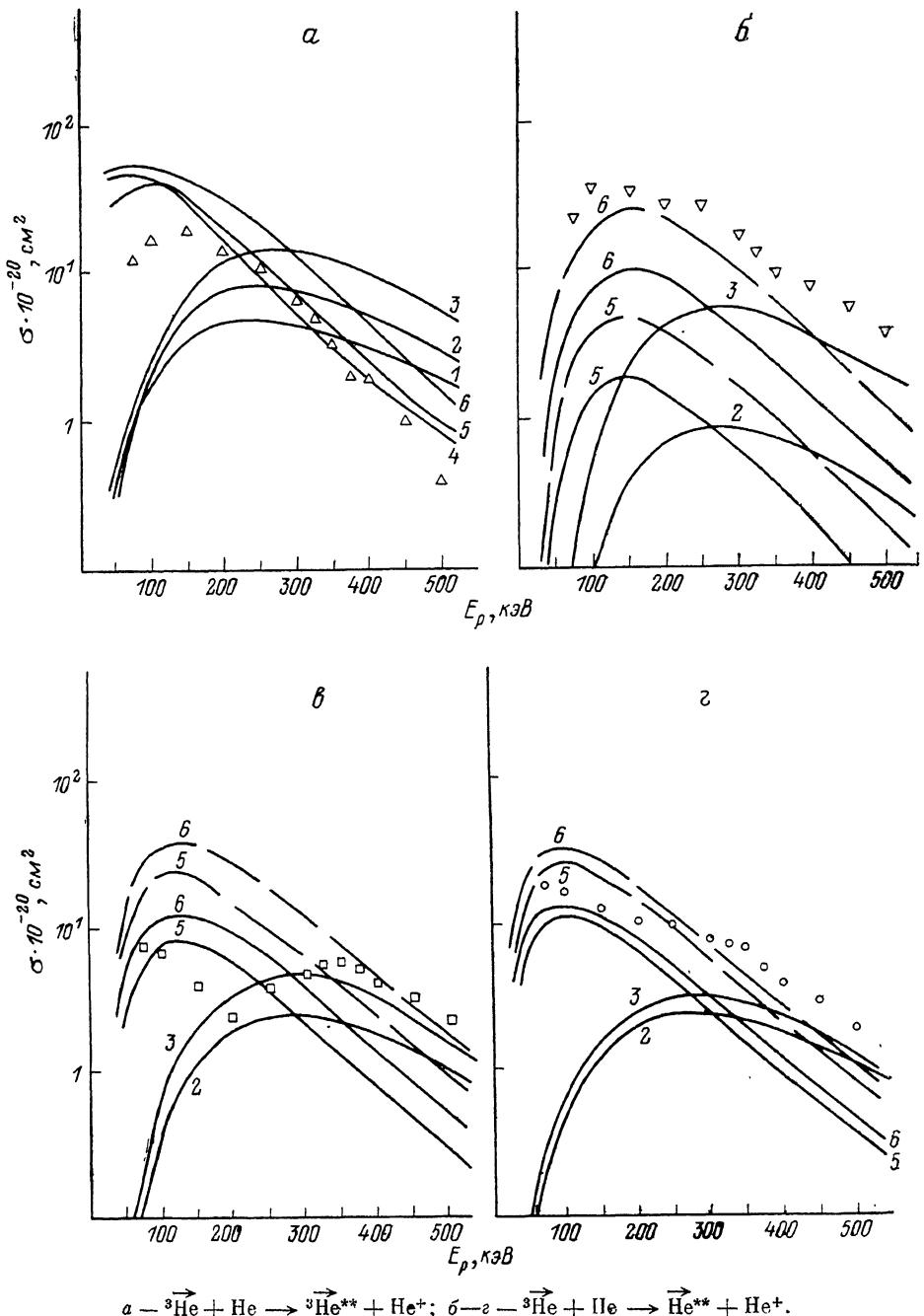
На основе изложенной выше теории были вычислены сечения образования  $(2s^2)^1S_-$ ,  $(2s2p)^3P_-$ ,  $(2p^2)^1D$ - и  $(2s2p)^1P$ -резонансов быстрых атомов гелия в столкновениях  ${}^3\text{He}^+ + \text{He}$  в области энергий сталкивающихся частиц от 100 до 500 кэВ. Результаты расчетов, выполненных по формулам (2) и (10) в различных приближениях, представлены на рисунке, а — вместе с имеющимися экспериментальными данными [2]. Для сопоставления экспериментальных и теоретических результатов сечения, вычисленные с амплитудой (10), были разделены на  $(2L+1)$ , поскольку экспериментальные данные [2] относятся к углу эджекции 0, когда в процессе столкновения заселяются состояния только с  $M=0$ . Кривые 1—3, показанные на рисунке, вычислялись в пренебрежении влиянием поля остатка атома мишени ( $v_i=0$ ) на движение электронов в АИС. Причем кривая 1 получена в плосковолновом приближении с функцией  $\Phi_{k,\epsilon}^+$ , в (10)  $\Phi_{k,\epsilon}^+ = \exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$ , кривая 2 — в импульсном приближении  $\Phi_{k,\epsilon}^+ = \Phi_k^+$ , где  $\Phi_k^+$  — кулоновская волна, описывающая состояния непрерывного спектра захватываемого электрона в поле налетающей частицы ( $\epsilon = k^2/2$ ) [7, 8], а кривая 3 — в полюсном приближении с

$$\Phi_{k,\epsilon}^+ = [1 - i\pi\delta(\epsilon - h_{2p}) V_{2p}] / \mathbf{k}. \quad (12)$$

Кривые 4—6 получены соответственно в тех же приближениях, что и кривые 1—3, но с учетом искажения АИС ( $v_i \neq 0$ ). Волновая функция начального состояния  $\psi_0$  определялась в водородоподобном приближении с эффективным зарядом  $Z_t = \sqrt{2I_t}$ , а волновая функция АИС  $\Phi_a^{LM}$  бралась в диагонализационном приближении [16].

Полученные результаты показывают, что сечения образования АИС при  $v_i=0$  имеют максимум при энергии налетающего иона  $E_p \simeq M_p(E_r + I_t)$ , а учет взаимодействия захватываемого электрона с налетающим ионом не изменяет качественно энергетической зависимости сечений при больших энергиях сталкивающихся частиц. Искажение АИС полем иона остатка мишени приводит к смещению максимума сечения в сторону меньших энергий столкновения, что ближе соответствует наблюдаемому экспериментально поведению сечений.

В целом качественное поведение рассчитанных сечений образования рассмотренных АИС с ростом энергии столкновения становится практически одинаковым, что согласуется с экспериментальными данными, за исключением  $(2p^2)^1D$ -состояния, которое обнаруживает минимум в сечении при энергии



столкновения  $E_p = 200$  кэВ. Появление этого минимума может быть вызвано двумя причинами: деструктивной интерференцией амплитуд коррелированных и некоррелированных переходов [8] или деструктивной интерференцией двух соседних близко расположенных резонансов  $(2p^2)^1D$  и  $(2s2p)^1P$ , которая может привести к видимому уменьшению выхода  $(2p^2)^1D$ -резонанса [11]. Для получения более полного согласия теоретических расчетов с экспериментом в этой

области энергий сталкивающихся частиц необходимо выйти за рамки приближений, используемых в настоящей работе, в частности рассмотреть образование АИС под действием потенциала  $W_0$ , а также отказаться от приближения изолированного резонанса.

Следует отметить, что экспериментальные сечения в [2] были получены в предположении изотропного распределения электронов в зависимости от угла эжеции. Такое предположение выполняется для  $(2s^2) ^1S$ -резонанса, если пре-небречь интерференцией с непрерывным спектром, тогда как для других резонансов остается приближенным и в этом случае. Для оценки влияния угловой анизотропии эжеции электронов на сечения образования АИС наряду с точными расчетами были проведены расчеты для  $(2s2p) ^1P$ ,  $^3P$ - и  $(2p^2) ^1D$ -резонансов с изотропным угловым распределением автоионизационных электронов (на рисунке,  $a-g$  результаты расчетов показаны штриховыми линиями). Видно, что учет их анизотропии приводит к систематическому уменьшению сечений образования АИС при перезарядке с возбуждением ионов на атомах. Отсюда следует вывод о том, что сечения образования АИС, полученные в работе [2], завышены. Их уточнение может привести к улучшению согласия теоретических результатов с экспериментальными данными.

В заключение следует отметить, что исследование механизмов образования АИС быстрых ионов в процессах перезарядки с возбуждением на атомах, предпринятое в настоящей работе для симметричных сталкивающихся систем ( $Z_p \approx Z_i$ ), показало следующее: заселение автоионизационных уровней иона при больших энергиях столкновения происходит в основном в результате взаимодействия между собой электронов мишени и налетающего иона, а взаимодействие совершающих переходы электронов с ионом-остатком атома мишени оказывается существенным в области промежуточных энергий столкновения и приводит к заметному росту сечений образования АИС.

#### Список литературы

- [1] *Tanis J. A., Bernstein E. M., Graham W. G. et al.* // Phys. Rev. Lett. 1982. Vol. 49. N 18. P. 1325–1328.
- [2] *Itoh A., Zouros T. J. M., Schneider D. et al.* // J. Phys. B. 1985. Vol. 18. N 23. P. 4581–4587.
- [3] *Zouros T. J. M., Schneider D., Stoltzfus N.* // J. Phys. B. 1988. Vol. 21. N 21. P. L671–L676.
- [4] *Pepmiller P. L., Richard P., Newcomb J.* // Phys. Rev. A. 1985. Vol. 31. N 2. P. 734–743.
- [5] *Stoltzfus N.* // XV ICPEAC / Ed. H. B. Gilbody, W. R. Newell, F. H. Read et al. Brighton, 1987. P. 661–667.
- [6] *Schowengerdt F. D., Rudd M. E.* // Phys. Rev. Lett. 1972. Vol. 28. N 3. P. 127–129.
- [7] *Clark M., Brandt D., Swenson J. K. et al.* // Phys. Rev. Lett. 1985. Vol. 54. N 6. P. 544–546.
- [8] *Feagin J. M., Briggs J. S., Reeves T. M.* // J. Phys. B. 1984. Vol. 17. N 6. P. 1057–1068.
- [9] Кунинеев Ш. Д., Сенченко В. С. // Тез. докл. X Всесоюз. конф. по физике электронных и атомных столкновений. Ужгород, 1988. Ч. I. С. 120.
- [10] Балашов В. В., Липовецкий С. С., Павличенков А. В. и др. // Вестник МГУ. Физика, астрономия. 1971. Т. 12. № 1. С. 65–74.
- [11] *Van der Straten P., Morgenstern R. J.* // J. Phys. B. 1986. Vol. 19. N 9. P. 1361–1370.

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт  
ядерной физики

Поступило в Редакцию  
17 июля 1989 г.